

CT-6000



・特徴

＜超高温材料研究用サーマルCVD＞

炭化ケイ素(SiC)に代表される超高温材料は、その生成温度と濃度によって様々な結晶構造をとります。CT-6000 はこれらの未来材料の研究をするために、制御圧力範囲を 6.65～101KPa、制御温度範囲を 800～2000℃と幅広く条件を取れるようになっています。

・仕様

膜種	SiC/C
炉体サイズ	φ168mm×210mm
炉体材質	カーボン
基板形状	自在
到達圧力	×10 ⁻² Pa 台※常温・無負荷・脱ガス時
排気速度	×10 ⁻¹ Pa 台迄5分以内※常温・無負荷・脱ガス時
加熱温度	2000℃
圧力コントロール	自動
ガス種	SiCl ₄ /C ₃ H ₈ /H ₂ /N ₂
真空排気系	油回転ポンプ：1200L/min メカニカルブースターポンプ：300m ³ /h
真空計	ピラニ真空計/バラトロン真空計
ユーティリティ	電気：AC200V 三相 60KVA 冷却水：60L/min 以上 0.1MPa 以上 0.15MPa 以下 25℃以下循環 計装エア：0.5MPa 以上